MAR 17 2004 WAR 17 2004 Under the Passinvork Reduction Act of 1995 TRANSMITTAL FORM (to be used for all correspondence after initial formulation of Pages in This Submission	Filing Date First Named Inventor Art Unit Examiner Name	PTO/SB/21 (08-03) Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031 at and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE on of information unless it displays a valid OMB control number. 10/708,047 02/05/2004 Wen-Huang Liu KYCP0014USA
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment/Reply After Final Affidavits/declaration(s) Extension of Time Request Express Abandonment Request Information Disclosure Statement Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Addres Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) Remarks Response to the office action has been see	After Allowance communication to Technology Center (TC) Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information
Firm or Individual name Signature Date CE I hereby certify that this correspondence is be	ERTIFICATE OF TRANSMISSION seing facsimile transmitted to the USPTO or	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

Date

PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$)	0.00
------	------

Complete if Known				
Application Number	10/708,047			
Filing Date	02/05/2004			
First Named Inventor	Wen-Huang Liu			
Examiner Name				
Art Unit				
Attorney Docket No.	KYCP0014USA			

METHOD OF PAYMEN	T (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card	Money Other None				_ FEE		
Deposit Account:					Entity		
Deposit 50,0004		Fee Code		Fee Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account 5U-0801 Number		1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Account	rnational Patent Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name The Director is authorized to: (check	k all that apply)	1053	130	1053	130	Non-English specification	
Charge fee(s) indicated below	Credit any overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s) or an		1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, exc	•	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after	
to the above-identified deposit accoun		1251	110	2251	66	Examiner action Extension for confushible first month	
FEE CALCU	LATION	1251 1252	420	2251	55 210	Extension for reply within first month Extension for reply within second month	
1. BASIC FILING FEE		1253	950	2253		Extension for reply within third month	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee De	scription Fee Paid		1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
Code (\$) Code (\$)			2,010	2255		Extension for reply within fifth month	
	filing fee	1401	330	2401	·		
	in filing fee	1401	330	2401		Notice of Appeal Filing a brief in support of an appeal	
	filing fee	1403	290	2402		Request for oral hearing	
	sue filing fee	ľ	1,510	1451		Petition to institute a public use proceeding	
		1452	110	2452		Petition to revive - unavoidable	
SUBTO	TAL (1) (\$) 0.00		1,330	2453		Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR	R UTILITY AND REISSUE		1,330	2501		Utility issue fee (or reissue)	
	Claims below Fee Paid		480	2502		Design issue fee	
Total Claims20** =	×	1503	640	2503	320	Plant issue fee	
Claims — - 3 =	X 	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
Multiple Dependent	L	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee F	e Description	1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$) Code (\$)		8021	40	802 ⁻	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
	ns in excess of 20 pendent claims in excess of 3	1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
	ple dependent claim, if not paid	1810	770	2810	385	For each additional invention to be	
	eissue independent claims	4004	770	2004	205	examined (37 CFR 1.129(b))	
	er original patent eissue claims in excess of 20	1801 1802	770 900	2801 1802	385 900		\vdash
	d over original patent	1002	J U U	1002	300	of a design application	
SUBTOTA	L (2) (\$) 0.00		fee (sp	· · -			
**or number previously paid, if grea		*Redu	iced by	Basic I	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

SUBMITTED BY	-	7.00				(Complete	(if applicable))
Name (Print/Type)	Winston Hsu	1 1 -	-4	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature		Wh	Mos	1 Ha	U	Date	3/15/2000

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

MAR 1 7 2004 35

PTO/SB/02B (11-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

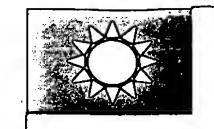
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

TRANSPINE The Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092120597	Taiwan R.O.C	07/25/2003		
	1			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



인당 인당 인당



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 07 月 25 日 Application Date

hppireation bate

申 請 案 號: 092120597

Application No./

申 請 人: 晶元光電股份有限公司

Applicant(s)

리오 (리오)

인 리 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이

局

長

Director General





33

發文日期: 西元 2003 年 12 月 12 日

Issue Date

發文字號:

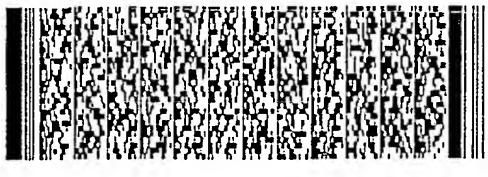
09221264920

Serial No.



申請日期:	IPC分類	
申請案號:		:

		
(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	具有複合基板之發光元件
發明名稱	英文	
	姓 名 (中文)	1. 劉文煌 2. 王仁水 3. 謝明勳
-	姓 名 (英文)	1. 2. 3.
發明人 (共3人)	國籍(中英文)	
	住居所(中文)	1. 新竹科學工業園區園區二路48號 2. 新竹科學工業園區園區二路48號 3. 新竹科學工業園區園區二路48號
_	住居所(英文)	1. 2. 3.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 晶元光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1.
゠	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 ROC
申請人(共1人)	住居所(營業所)	1. 新竹科學工業園區園區二路48號 (本地址與前向貴局申請者不同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1.
·	代表人(中文)	1. 禁寅夫
	代表人(英文)	1.
■ 田 北京 単原 八代 にり	RELEVES/JECULE	[14] 5 () 安徽 ([4]) [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]



四、中文發明摘要 (發明名稱:具有複合基板之發光元件)

一種具有複合基板之發光元件,其包含一複合基板,其中該複合基板包含一高熱傳導層以及圍繞於該高熱傳導層問圍之基板;形成於該複合基板上之一黏結層;形成於該黏結層上之一發光疊層。如此可解決晶粒切割時,金屬層不易切割之困難。

五、(一)、本案代表圖為:第____圖(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

1 發光元件

10 複合基板

101 高熱傳導層

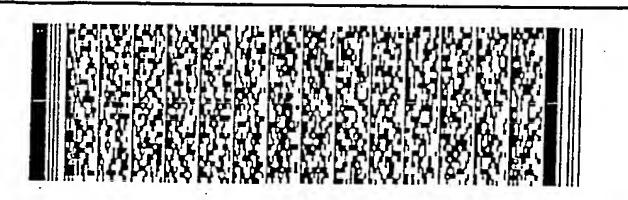
102 基板

金屬反射層

12 透明黏結層

13 透明導電層

六、英文發明摘要 (發明名稱:)



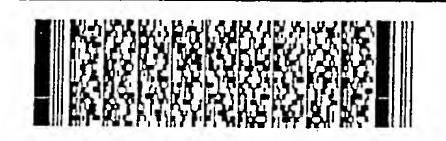
四、中文發明摘要 (發明名稱:具有複合基板之發光元件)

14 發光疊層

15 第一接線電極

16 第二接線電極

六、英文發明摘要 (發明名稱:)



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		•	
		無	•
		,	•
ı			
		· .	•
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	- 先權:	•
申請案號:		t-	
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	□第一款但書:	或□第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存	於國外:		
寄存國家: 寄存機構:		無	-
寄存日期: 寄存號碼:	•		
□有關微生物已寄存	於國內(本局所指)	定之寄存機構):	
寄存機構: 寄存日期:	· .	無	
寄存號碼:			•
□熟習該項技術者易:	於獲得,不須寄存	o	
	•		
		· .	
			•

五、發明說明 (1)

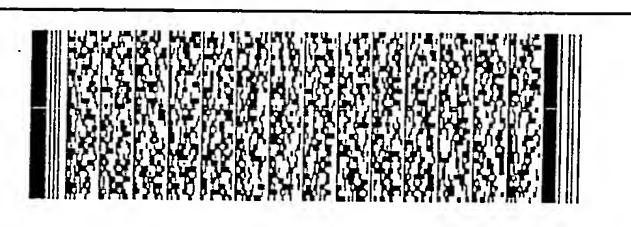
發明技術領域

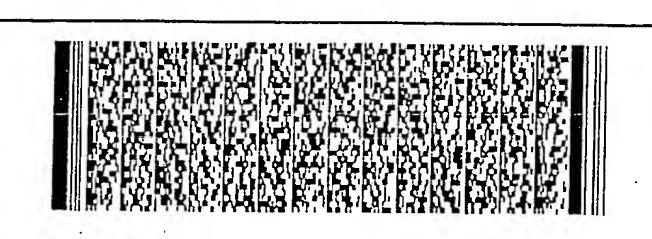
本發明係關於一種發光元件,尤其關於一種具有複合基板之發光元件。

發光元件之應用頗為廣泛,例如,可應用於光學顯示裝置、雷射二極體、交通號誌、資料儲存裝置、通訊裝置、照明裝置、以及醫療裝置。

先前技術

於美國專利第6287882號揭露一種發光二極體,其以





二、發明說明 (2)

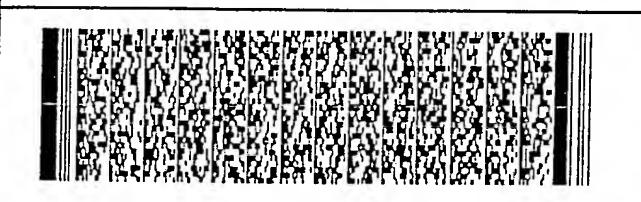
金屬反射黏結劑黏結一發光單元以及一金屬基板,使得該發光二極體具有反射之功能。於中華民國其利第151410號揭露一種具有金屬基板的半導體元件,與利用電鍍法將金屬材料鍍於半導體發光疊層上,形成到屬基板取代傳統半導體基板,來達到熱的功能。但是上述兩種結構在製程中,後段晶粒切割時,金屬基板在切割上有其困難度。

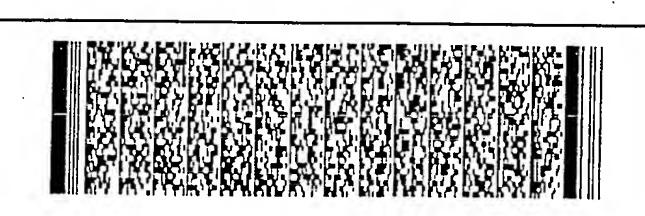
發明內容

本案發明人於思考如何解決前述之問題時,認為若利用一複合基板,其中該複合基板由一高熱傳導層以及團繞於高熱傳導層間之基板;以一黏結層將該複合基板與一發光疊層結合在一起。如此,該複合基板兼具金屬基板之提供熱能散逸功能,同時在晶粒切割時,直接切割複合基板中之基板部分,如此可解決晶粒切割時,金屬基板不易切割之困難。

本發明之主要目的在於提供一種具有複合基板之發光元件,利用一複合基板,其中該複合基板由一高熱傳導層以及圍繞於高熱傳導層問圍之基板。如此,該複合基板具備金屬基板之提供熱能散逸功能,以解決發光元件中熱能無法即時移除之問題。

本發明之另一目的在於提供一種具有複合基板之發





五、發明說明 (3)

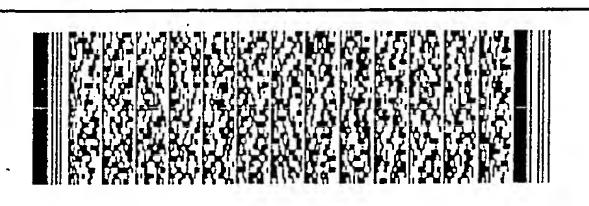
光元件,在晶粒切割時,直接切割該複合基板中之基板,如此可解決晶粒切割時,金屬基板不易切割之問題。

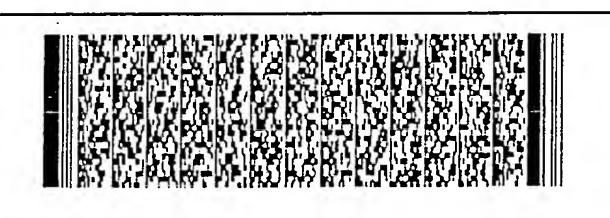
依本發明一較佳實施例具有複合基板之發光元件,包含一複合基板,其中該複合基板係由一高熱傳導層以及圍繞於高熱傳導層周圍之基板組成;以一黏結層將該複合基板與一發光疊層結合在一起。

前述之高熱傳導層係包含選自Cu、A1、Au、Ag、W及其合金所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料;前述之基板係包含選自Si、GaAs、Ge、A12O3、玻璃、InP及GaP所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。

實施方式

請參閱圖1,依本發明一較佳實施例1具有複合基板之發光元件1,包含一複合基板10,其中該複合基板包含一高熱傳導層101以及圍繞於高熱傳導層問圍之基板102;形成於該複合基板上之一金屬反射層11;形成於該金屬反射層上之一透明黏結層12;形成於該透明黏結層上之一透明導電層13,其中,該透明導電層之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域;形成於該第一表面區域上之一發光疊層14;形成於該第二表面區域上之





五、發明說明 (4)

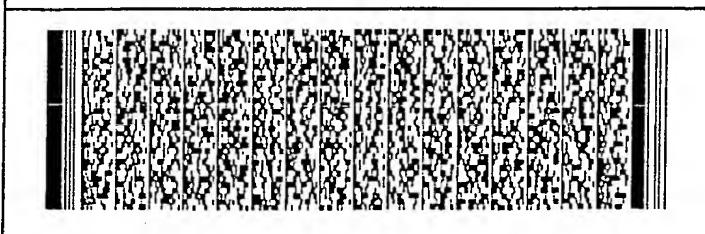
一第一接線電極15;以及形成於該發光疊層上之一第二接線電極16。

上述之實施例1中,於該金屬反射層及該透明黏結層之間可形成一第一反應層;於該透明黏結層及該透明導電層之間可形成一第二反應層,以提高之間的附著力。

上述之實施例1中,該金屬反射層亦可形成於透明黏結層與透明導電層之間。另外上述之實施例中該透明黏結層亦可以不透明黏結層取代,同時該金屬反射層形成於不透明黏結層與透明導電層之間。

請參閱圖2,依本發明一較佳實施例2具有複合基板之發光元件2,包含一複合基板20,其中該複合基板包含一高熱傳導層201以及圍繞於高熱傳導層周圍之基板202;形成於該複合基板上之一金屬反射層21;形成於該金屬反射層上之一導電透明黏結層22;形成於該導電透明黏結層上之一透明導電層23;形成於該透明導電層上之一發光疊層24;以及形成於該發光疊層上之一接線電極25。

上述之實施例2中,於該金屬反射層及該導電透明黏結層之間可形成一第一反應層;於該導電透明黏結層及該透明導電層之間可形成一第二反應層,以提高之間



五、發明說明 (5)

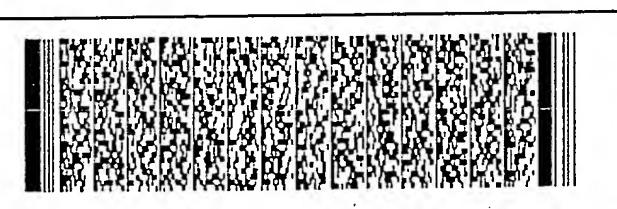
的附著力。

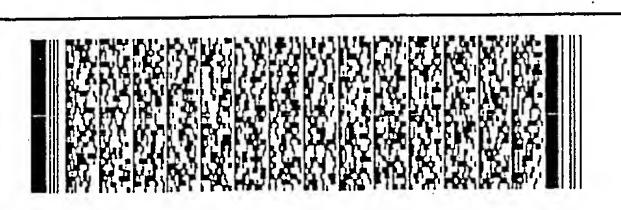
上述之實施例中,該金屬反射層亦可形成於導電透明黏結層與透明導電層之間。另外上述之實施例中該導電透明黏結層亦可以導電黏結層取代,同時該金屬反射層形成於導電黏結層與透明導電層之間。

請參閱圖3,依本發明又一較佳實施例3具有複合基板之發光元件3,包含一複合基板30,其中該複合基板包含一高熱傳導層301以及圍繞於高熱傳導層周圍之基板302; 形成於該複合基板上之一金屬黏結層31;形成於該金屬黏結層上之一發光疊層32;以及形成於該發光疊層上之一接線電極33

於上述之各實施例1,2或3中,於複合基板之高熱傳導層及基板之間可形成一連結層,使得高熱傳導層及基板間之接合力更強。

前述高熱傳導層可以為單一個或複數個之高熱傳導層型態存在;前述高熱傳導層的形成方法係包含選自電鍍,電鑄,無電解電鍍及電弧蒸鍍之中至少一種方法或其他可替代之方法;前述高熱傳導層係包含選自Cu、Al、Au、Ag、W及其合金所構成材料族群中之至少一種材料;前述連結層係包含選自氧化銦錫、GeAu、BeAu、

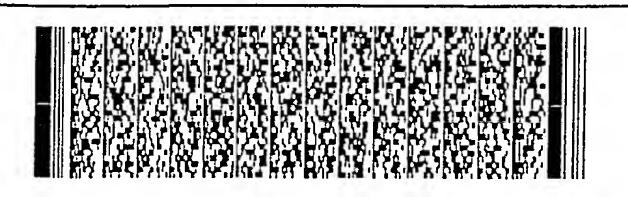


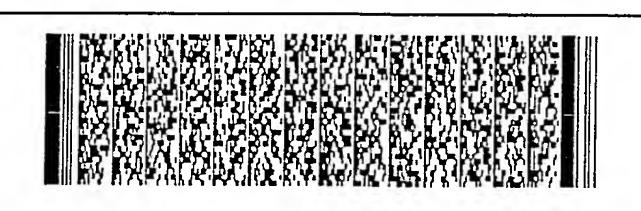


五、發明說明 (6)

SiNx、SiO2、Au、Cu、Ti及Pd所構成材料組群中之至少 種材料;前述之基板係包含選自Si、GaAs、Ge、A1203 玻璃、InP及GaP所構成材料族群中之至少一種材料;前 述發光疊層係包含AlGaInP、AlInGaN及AlGaAs系列所構 成材料族群中之至少一種材料;前述透明黏結層係包含 選自於聚醯亞胺(PI)、苯并環丁烷(BCB)或過氟環丁烷 (PFCB)所構成材料組群中之至少一種材料;該導電透明 黏結層包含選自於自發性導電高分子(Intrinsically conducting polymer)或高分子中掺雜導電材質所構成材 料組群中之至少一種材料,其中,該導電材質包含選自 於氧化銦錫、氧化镉錫、氧化锑錫、氧化鋅、氧化鋅 錫、Au及Ni/Au所構成材料組群中之至少一種材料;前述 _第一反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群 中之至少一種材料;前述第二反應層係包含選自於 SiNx、Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料;前述 金屬反射層係包含選自於In、Sn、Al、Au、Pt、Zn、 Ge、Ag、Ti、Pb、Pd、Cu、AuBe、AuGe、Ni、PbSn 或 AuZn所構成材料組群中之至少一種材料;前述金屬黏結 層係包含選自於In、Sn、Al、Au、Pt、Zn、Ge、Ag、 Ti、Pb、Pd、Cu、AuBe、AuGe、Ni、PbSn或AuZn所構成 材料组群中之至少一種材料。

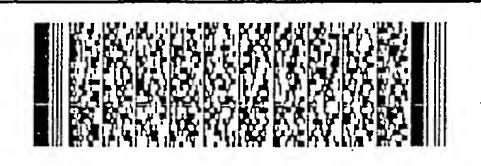
雖然本發明之發光元件已以較佳實施例揭露於上,然本發明之範圍並不限於上述較佳實施例,應以下述申請專





五、發明說明 (7)

利範圍所界定為準。因此任何熟知此項技藝者,在不脫離本發明之申請專利範圍及精神下,當可做任何改變。



圖式簡單說明

圖式之簡單說明:

圖1為一示意圖,顯示依本發明一較佳實施例之一種 具有複合基板之發光元件。

圖2為一示意圖,顯示依本發明另一較佳實施例之一種具有複合基板之發光元件。

圖3為一示意圖,顯示依本發明又一較佳實施例之一種具有複合基板之發光元件。

符號說明

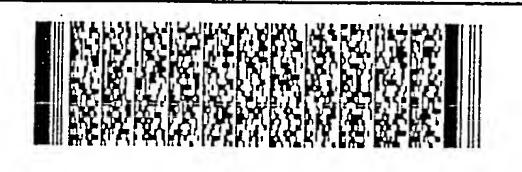
1	發	光	元	件		
1 0	複	合	基	板		
1 0 1	高	熱	傳	導	層	
102	基	板	-			•
1 1	金	屬	反	射	層	
1 2	透	明	黏	結	層	
1 3	透	明	導	電	層	
1 4	發	光	豐	層		
1 5	第		接	線	電	極
1 6	第		接	線	電	極
2	發	光	元	件	•	
2 0	複	合	基	板		
201	高	熱	傳	導	層	
202	基	板				
2 1	金	屬	反	射	層	



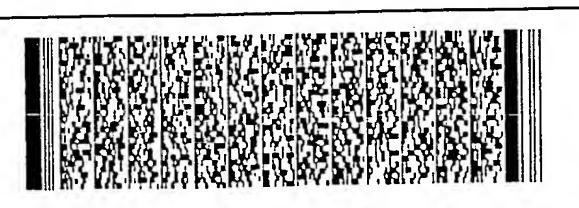
圖式簡單說明等表明表編月23透明專層」24發光層」25接線元件3發光元件30複合基板

3 0 1	高	熱	傳	導	層
302	基	板			
3 1	金	屬	黏	結	層

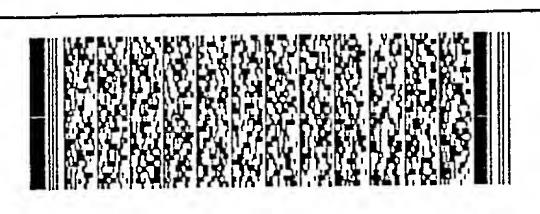
3 2	發	光	置	層
33	接	線	電	極



- 1. 一種具有複合基板之發光元件,包含:
- 一複合基板,其中該複合基板包含一高熱傳導層以及圍繞於高熱傳導層周圍之基板;
- 形成於該複合基板上之一黏結層;以及
- 形成於該黏結層上之一發光疊層。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該黏結層為一透明黏結層。
- 3. 如申請專利範圍第2項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該透明黏結層為一透明導電黏結層。
- 4. 如申請專利範圍第2項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該透明黏結層為一透明不導電黏結層。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該黏結層為一不透明黏結層。
- 6. 如申請專利範圍第5項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該不透明黏結層為一不透明導電黏結層。
- 7. 如申請專利範圍第5項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該不透明黏結層為一不透明不導電黏結層。

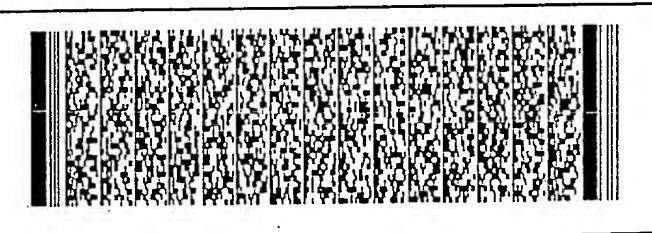


- 8. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,於該複合基板及該黏結層之間更包含一第一反應層。
- 9. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,於該黏結層及該發光疊層之間更包含一第二反應層。
- 10. 如申請專利範圍第8項所述之具有複合基板之發光元件,其中,於該複合基板及該第一反應層之間更包含一金屬反射層。
- 11. 如申請專利範圍第9項所述之具有複合基板之發光元件,其中,於該第二反應層及該發光疊層之間更包含一金屬反射層。
- 12. 如申請專利範圍第11項所述之具有複合基板之發光元件,其中,於該金屬反射層及該發光疊層之間更包含一透明導電層。
- 13. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該黏結層係一金屬黏結層。
- 14. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元



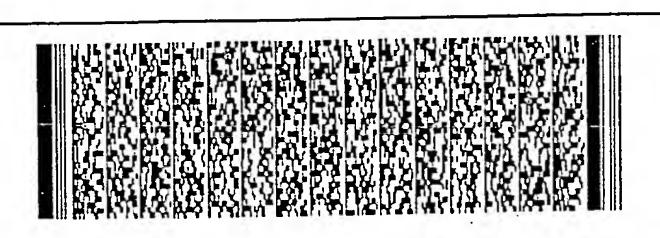
件,其中,該黏結層係一金屬反射黏結層。

- 15. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,於該高熱傳導層及該基板之間更包含一連結層。
- 16.如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該高熱傳導層係包含選自Cu、Al、Au、Ag、W及其合金所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 17. 如申請專利範圍第15項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該連結層係包含選自氧化錮錫、GeAu、BeAu、Au、SiNx、SiO₂、Cu、Ti及Pd所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 18. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該基板係包含選自Si、GaAs、Ge、A1203、玻璃、InP及GaP所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 19. 如申請專利範圍第2項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該透明黏結層係包含選自於聚醯亞胺(PI)、苯并環丁烷(BCB)及過氟環丁烷(PFCB)所構成材料族群中



之至少一種材料或其他可替代之材料。

- 20. 如申請專利範圍第3項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該透明導電黏結層係包含選自於自發性導電高分子(Intrinsically conducting polymer)或高分子中掺雜導電材質所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 21. 如申請專利範圍第20項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該導電材質包含選自於氧化銦錫、氧化鍋錫、氧化鍋、氧化鋅錫、Au及Ni/Au所構成材粉族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 22. 如申請專利範圍第13項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該金屬黏結層係包含選自In、Sn、Al、Au、Pt、Zn、Ge、Ag、Ti、Pb、Pd、Cu及其合金所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 23. 如申請專利範圍第14項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該金屬反射黏結層係包含選自In、Sn、Al、Au、Pt、Zn、Ge、Ag、Ti、Pb、Pd、Cu及其合金所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 24. 如申請專利範圍第1項所述之具有複合基板之發光元



件,其中,該發光疊層係包含AlGaInP、AlInGaN及AlGaAs系列所構成材料組群中之至少一種材料或其他可替代之材料。

- 25. 如申請專利範圍第8項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該第一反應層係包含選自SiNx、Ti及Cr所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。
- 26. 如申請專利範圍第9項所述之具有複合基板之發光元件,其中,該第二反應層係包含選自SiNx、Ti及Cr所構成材料族群中之至少一種材料或其他可替代之材料。

